

圖 6-11 STI 溝槽的形成。

(2)氧化物充填：如圖 6-12 所示，先將晶片置於高溫氧化爐中，在STI曝露的地方成長一層非常薄的氧化層（Liner），此氧化層主要是讓矽與之後溝槽充填的CVD 氧化物有良好的介面品質。

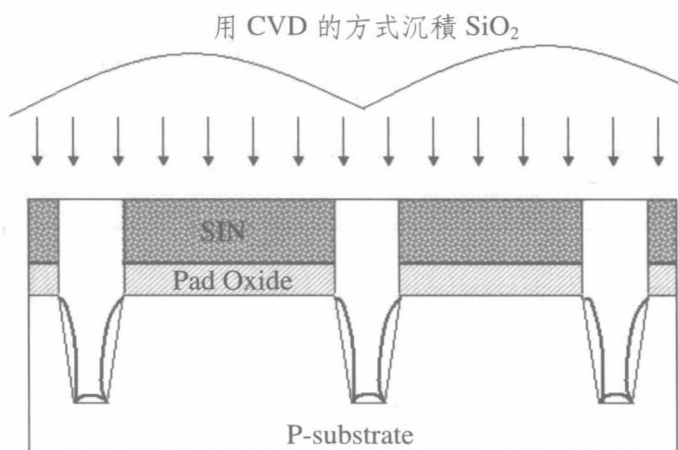


圖 6-12 STI 氧化物充填。

(3)氧化層研磨和氮化矽去除：如圖 6-13 所示，使用 CMP 將已充填完成的CVD 氧化物和SiN 層磨平及拋光，最後用熱磷酸去除表面所殘留的SiN。